

สารบัญ

ปกใน	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
รายการรูป	ช
รายการตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของ โครงการวิจัย	5
1.3 ขอบเขตของ โครงการวิจัย	5
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	6
1.5 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง	6
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	8
2.1 การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปีดเทอริง	8
2.2 กลไกการเกิดฟิล์มบาง	22
2.3 สมบัติพื้นฐานของไททานเนียมไดออกไซด์	25
2.4 ประโยชน์ของไททานเนียมไดออกไซด์	27
2.5 ปฏิกิริยาการนำโฟโตคะตะลิซิสในไททานเนียมไดออกไซด์	28
2.6 สภาพชอบน้ำ (Hydrophilic)	30
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	31
3.1 วิธีดำเนินการวิจัย	31
3.2 การวิเคราะห์สมบัติของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์	32
3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการวิจัย	33
บทที่ 4 ผลการทดลอง	41
4.1 การศึกษาอิทธิพลของการป้อนก๊าซออกซิเจน	41
4.2 การศึกษาอิทธิพลของกำลังไฟฟ้า	44
4.3 การศึกษาอิทธิพลของความหนาฟิล์ม	55
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	59
5.1 สรุปผล	59

5.2 ข้อเสนอแนะ	59
เอกสารอ้างอิง	60
ภาคผนวก	62
ก. การหาความหนาฟิล์มจากสเปกตรัมเปอร์เซ็นต์การส่งผ่าน ที่ใช้หลักการแทรกสอดของแสง	62
ข. ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ	65

รายการรูป

รูปที่ 1.1	ลักษณะของหยดน้ำบนกระจกบริเวณที่เคลือบฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ และบริเวณที่ไม่เคลือบ	2
รูปที่ 1.2	การเปรียบเทียบกระบวนการโฟโตคะตะลิซิสของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ กับการสังเคราะห์แสงของ Chlorophyll	3
รูปที่ 1.3	การนำหลักการโฟโตคะตะลิซิสไปประยุกต์	3
รูปที่ 2.1	ประเภทของกระบวนการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ	8
รูปที่ 2.2	อันตรกิริยาระหว่างไอออนและผิวเป่าสารเคลือบ	10
รูปที่ 2.3	กระบวนการเคลือบภายใต้สุญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอร์ริง	11
รูปที่ 2.4	ลักษณะการโก่งตัวสสารระหว่างขั้วอิเล็กโตรด	13
รูปที่ 2.5	ระบบการเคลือบฟิล์มแบบ ดีซี สปัตเตอร์ริง	14
รูปที่ 2.6	ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่าซีลด์ และกระแสไฟฟ้า ในระบบสปัตเตอร์ริงของนิเกิลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 โวลต์ ระหว่างขั้ว อิเล็กโตรด ที่วางห่างกัน 4.5 เซนติเมตร	15
รูปที่ 2.7	การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก	16
รูปที่ 2.8	การเคลื่อนที่ของอนุภาค โดยที่ a, b และ c เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุใน สนามแม่เหล็ก d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กและสนาม ไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ	18
รูปที่ 2.9	การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกัดเป่าสารเคลือบในระบบเคลือบฟิล์ม พลาสมาแมกนีตรอน สปัตเตอร์ริง	18
รูปที่ 2.10	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีลด์ของการสปัตเตอร์กับค่าเลขอะตอมของ เป่าสารเคลือบโดยเร่ง Ar^+ , Ne^+ และ Hg^+ เข้าชนเป่าสารเคลือบชนิดต่าง ๆ	20
รูปที่ 2.11	ค่าซีลด์ของการสปัตเตอร์ที่สัมพันธ์กับค่ามุมตกกระทบของไอออนที่เข้าชน	21
รูปที่ 2.12	โครงสร้างของการเกิดฟิล์มในรูปแบบต่าง ๆ	25
รูปที่ 2.13	โครงสร้างโมเลกุลของไททาเนียมไดออกไซด์แบบ (ก) Rutile และ (ข) Anatase	26
รูปที่ 2.14	ช่องว่างพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์	27
รูปที่ 2.15	กระบวนการฉายแสงอัลตราไวโอเลตฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์	29
รูปที่ 2.16	แสดงสภาพไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) และสภาพชอบน้ำ (Hydrophilic) ตามลำดับ	30

รูปที่ 3.1	แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิจัยสำหรับศึกษาตัวแปรต่อสมบัติของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์	32
รูปที่ 3.2	เครื่อง DC Pulse Magnetron Sputtering	35
รูปที่ 3.3	ขั้วแคโทดภายในแชมเบอร์	35
รูปที่ 3.4	เป้าไททานเนียมที่ใช้ในการวิจัย	35
รูปที่ 3.5	เครื่อง X-Ray Diffractometer	38
รูปที่ 3.6	Atomic force microscope	38
รูปที่ 3.7	เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์	39
รูปที่ 3.8	ภายในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์	39
รูปที่ 3.9	(ก) Contact angle meter และ (ข) แหล่งกำเนิดแสงยูวีความเข้ม 1.2 mW/cm^2	40
รูปที่ 4.1	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเคลือบฟิล์มกับอัตราการป้อนก๊าซออกซิเจนของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์เคลือบที่กำลังไฟฟ้า 500 W	42
รูปที่ 4.2	ความสัมพันธ์ระหว่าง Target voltage และ Sputtering current กับอัตราการป้อนก๊าซออกซิเจนโดยใช้กำลังไฟฟ้า 500 W ในการเคลือบฟิล์ม	43
รูปที่ 4.3	ความสัมพันธ์ของเวลาหลังฉายรังสีอัลตราไวโอเลตที่ความเข้ม 1.2 mW/cm^2 กับมุมสัมผัสหยดน้ำของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์เคลือบด้วยกำลังไฟฟ้า 500 W ที่อัตราการป้อนก๊าซออกซิเจนค่าต่าง ๆ	44
รูปที่ 4.4	ค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านในช่วงความยาวคลื่น 190 – 2500 nm ของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์ เคลือบที่เวลา 1000 s ด้วยกำลังไฟฟ้าค่าต่าง ๆ	45
รูปที่ 4.5	ค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านในช่วงความยาวคลื่น 190 – 2500 nm ของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์ เคลือบที่เวลาต่าง ๆ ด้วยกำลังไฟฟ้า (a) 100 W, (b) 200 W, (c) 300 W, (d) 400 W และ (e) 500 W	46
รูปที่ 4.6	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเคลือบ กับกำลังไฟฟ้าค่าต่าง ๆ ที่ใช้เคลือบฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์	48
รูปที่ 4.7	ค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านในช่วงความยาวคลื่น 190 – 2500 nm ของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์ หนา 100 nm เคลือบที่กำลังไฟฟ้าค่าต่าง ๆ	48
รูปที่ 4.8	ภาพ AFM 3 มิติ ของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์เคลือบที่กำลังไฟฟ้า (a) 100 W, (b) 200 W, (c) 300 W, (d) 400 W และ (e) 500 W	50
รูปที่ 4.9	ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเกรนและความขรุขระพื้นผิวกับกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการเคลือบฟิล์ม	51

- รูปที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่สะสมบนแผ่น Substrate กับความหนาของฟิล์มที่เพิ่มขึ้นขณะเคลือบที่กำลังไฟฟ้าค่าต่าง ๆ 51
- รูปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ของเวลากับมุมสัมผัสหยดน้ำของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์เคลือบที่กำลังไฟฟ้า 100 – 500 W หลังฉายแสงยูวี ด้วยความเข้ม 1.2 mW/cm^2 (a) ที่เวลาต่าง ๆ และ (b) หลังฉายแสงยูวีนาน 2 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้ไว้ในที่มืด 53
- รูปที่ 4.12 ภาพหยดน้ำบนฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์หนา 100 nm หลังฉายแสงอัลตราไวโอเลต ความเข้ม 1.2 mW/cm^2 นาน 80 นาทีเตรียมที่กำลังไฟฟ้า (a) 100 W, (b) 200 W, (c) 300 W, (d) 400 W และ (e) 500 W 54
- รูปที่ 4.13 ค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านในช่วงความยาวคลื่น 190 – 2500 nm ของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์เคลือบด้วยกำลังไฟฟ้า 500 W ที่ความหนาต่าง ๆ 56
- รูปที่ 4.14 รูปแบบการเลี้ยวเบน X-ray ของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์เคลือบด้วยกำลังไฟฟ้า 500 W ที่ความหนาต่าง ๆ ของฟิล์ม 56
- รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ของเวลากับมุมสัมผัสหยดน้ำของฟิล์มไททานเนียมไดออกไซด์หลังฉายแสงอัลตราไวโอเลตด้วยความเข้ม 1.2 mW/cm^2 เคลือบที่ความหนาฟิล์มค่าต่าง ๆ 57

รายการตาราง

ตารางที่ 1.1 การนำหลักการโฟโตะคะตะลิซิสไปประยุกต์ใช้	4
ตารางที่ 2.1 สมบัติพื้นฐานของไททาเนียมไดออกไซด์ทั้ง 3 เฟส	26
ตารางที่ 4.1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่อัตรา การป้อนก๊าซออกซิเจนค่าต่าง ๆ	41
ตารางที่ 4.2 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์หนา 100 nm ด้วยกำลังไฟฟ้าค่าต่าง ๆ	47
ตารางที่ 4.3 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์ม TiO_2 ที่ความหนาต่าง ๆ	55